

Наименование параметра	Буквенное обозначение	Значение параметра для тиристорных типов		Условия установления норм на параметры
		ТБ251-80	ТБ251-100	
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для класса: 6 7 8 9 10 11 12 13 14	U_{DRM} U_{RRM}	600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400		$T_{jmin} \leq T_j \leq T_{jm}$. Напряжение – синусоидальное однополупериодное, $t_p = 10$ мс, $f = 50$ Гц Цепь управления разомкнута
Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и неповторяющееся импульсное обратное напряжение, В	U_{DSM} U_{RSM}	$1,1U_{DRM}$ $1,1U_{RSM}$		$T_{jmin} \leq T_j \leq T_{jm}$. Напряжение – синусоидальное однополупериодное, $t_p = 10$ мс, одиночные импульсы. Цепь управления разомкнута
Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии и рабочее импульсное обратное напряжение, В	U_{DWM} U_{RWM}	$0,7U_{DRM}$ $0,7U_{RRM}$		$T_{jmin} \leq T_j \leq T_{jm}$. Напряжение – синусоидальное однополупериодное, $t_p = 10$ мс, $f = 50$ Гц
Постоянное напряжение в закрытом состоянии и постоянное обратное напряжение, В	U_D U_R	$0,5U_{DRM}$ $0,5U_{RRM}$		$T_{jmin} \leq T_c \leq 85^\circ C$. Цепь управления разомкнута
Обратное импульсное напряжение управления, В	U_{RGM}	5		$T_{jmin} \leq T_j \leq T_{jm}$
Средний ток в открытом состоянии, А	I_{TAV}	80 90	100 115	$T_c = 90^\circ C$ $T_c = 85^\circ C$ Ток – синусоидальный однополупериодный. Угол проводимости $\theta = 180^\circ$ эл.

				f = 50 Гц
Действующий ток в открытом состоянии, А		126	157	T _c = 90° С
Ударный ток в открытом состоянии, кА	I _{TRMS}	1,6 1,8	2 2,2	T _j = T _{jm} T _j = 25° С. Ток – синусоидальный, однополупериодный, t _p = 10 мс, U _R = 0 В. Режим в цепи управления: форма напряжения трапецеидальная, длительность фронта импульса 5 мкс, длительность импульса 50 мкс, напряжение ХХ источника управления 10–20 В, внутреннее сопротивление источника управления 5–10 Ом
Защитный показатель, А ² ·с	∫ i ² dt	12,8 × 10 ³	20 × 10 ³	T _j = T _{jm}
		16,2 × 10 ³	24,2 × 10 ³	T _j = 25° С. Ток – синусоидальный, однополупериодный t _p = 10 мс, U _R = 0 В
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, А/мкс	(di _T /dt) _{crit}	1250		T _j = T _{jm} U _D = 0,67U _{DRM} Ток – синусоидальный, однополупериодный, I _T ≤ 400 А, f ≤ 5 Гц. Режим в цепи управления: форма напряжения трапецеидальная, длительность фронта импульса 1 мкс, длительность импульса 10 мкс, напряжение ХХ источника управления 20 В, внутреннее сопротивление источника управления 1–3 Ом

Температура хранения, ° С: максимально допустимая минимально допустимая	T_{stgmax} T_{stgmin}	50 -60 (УХЛ)	—
Температура перехода, ° С: максимально допустимая минимально допустимая для исполнения: УХЛ У Т	T_{jm} T_{jmin}	125 -60 -50 -10	—
Растягивающее усилие, Н, для вывода: катодного управляющего и дополнительного катодного	—	80 40	—
Крутящий момент, Н·м	—	15±3	—